# 非镜象张氏电极的设计和加工程序

#### 徐春生

(合肥日用化工总厂, 合肥)

**摘要:**本文在张氏电极理论及其设计程序的基础上,提出了非镜象张氏电极的概念及其设计理论和设计程序。本文还介绍了张氏电极的数控加工程序。

The procedure for non-symmetry Chang-electrode design and production

#### Xu Chunsheng

(Hefei Daily use Chemical General Factory)

Abstract: Based on the Chang-electrode theory and its procedure designing, the concept, design theory and procedure about the non-symmetry Chang-electrode are described. The process of the Chang-electrode with numerically-controlled machinery.

准分子激光器和其它种类的激光器中,主放电电极的截面要求有适当的形状,使得电极 范围内的电场强度分布均匀,电极边缘附近的电场强度低于电极范围内的电场强度,这样才 能保证大体积范围内的均匀放电。

现在,已有很多种能近似满足上面要求的电极剖面,其中以Rogowski电极和张氏电极 最为常见。

Rogowski电极的剖面方程为[1]。

$$y = \frac{a}{\pi} \exp \left(\frac{\pi x}{a}\right) + \frac{a}{2} \tag{1}$$

实际设计中用光滑连接的直线、正弦曲线和圆弧线来代替(1) 所给的曲线,这样的电极 具有加工简单性和一定的有效性。

1973年,张提出了一簇由双曲函数线构成的分析剖面[2],这种电极剖面在平滑性、紧致性、均匀性等方面都优于Rogowski电极。

## 一、张氏电极设计理论和镀象电极设计[2,3]

张氏电极剖面簇源于下列的保角变换:

$$z = \omega + k \operatorname{sh} \omega \tag{2}$$

式中,z=x+iy, $\omega=u+iv$ ,x,y是空间坐标,u、v是电通量和电位函数,且k>0。对于每一个v值 ( $|v|<\pi$ ) 对应的等电位剖面为:

$$x = u + k \cos v \sin u \tag{3}$$

(4)

$$u = v + k \sin v \operatorname{ch} u$$

**4是参变量。注意,每个**等势面都是y轴对称的。而且共轭等位面v和-v所对应的两个面是x轴**对称的。因此,**我们只需研究v为正值且限于第一象限就足够了。

由电动力学可给出下列的电场表达式:

$$E^{-2} = |dz/d\omega|^2 = (1 + k\cos v \cosh u)^2 + (k\sin v \sinh u)^2$$
 (5)

可将其展开成u的级数形式如下:

$$E = a_0(v) + a_2(v)u^2 + a_4(v)u^4 + \cdots$$
 (6)

**奇数项因考**虑对称性而消失。为在电极中央(u=0)附近获得最大平坦电场分布,要求  $a_2(v)=0$ ,即 $\partial^2 E^{-2}/\partial^2 u \mid_{u=0}=0$ ,由此可导出:

$$v = \arccos(-k) = \pi/2 + \arcsin(-k) \tag{7}$$

设 $y_0$ 为电极中央的点, $x_m$ 、 $y_m$ 、 $u_m$  分别为电极边缘的x、y、u 的值,由(3)、(4)、(7) 式可得。

$$x_m/y_0 = (u_m - k^2 \sin u_m)/\arccos(-k) + k\sqrt{1 - k^2}$$
 (8)

一般取电极厚度为电极间距的1/4, 即 $y_n = 3y_0/2$ , 则有:

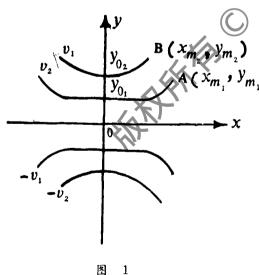
$$chu_m = arc \cos(-k)/2k\sqrt{1-k^2} + 3/2$$
 (9)

由(8)、(9)式即可确定电极纵横比 $x_m/y_0$ 和k的关系,在给定纵横比的情况下,求出电极方程中的参量k再由(7)式求出相应的v即可得电极剖面方程。

上述计算需要使用迭代法。

#### 二、非键象张氏电极的设计

如图1所示的等v曲线簇,镜象电极为选取 $v = v_1$ 和 $v = -v_1$ 作为上下剖面的 电 极,非镜象电极则为选取 $v = v_1$ 和 $v = -v_2$ ( $v_1 \neq v_2$ )作为上下剖面的电极。



此时,上电极方程为:

$$x_1 = u + k \cos v_1 \sinh u \tag{10}$$

$$y_1 = v_1 + k \sin v_1 \operatorname{ch} u \tag{11}$$

下电极方程为,

$$x_2 = u + k \cos v_2 \sinh u \tag{12}$$

$$y_2 = v_2 + k \sin v_2 \operatorname{ch} u \tag{13}$$

为计算方便,我们考虑的下电极的 v 值暂 且取正。

要确定 k、 $v_1$ 、 $v_2$  需要有实际的电极尺寸和间距,一般情况下是根据电场均匀度的要求给出 $x_{m_1}$ ,  $y_{m_1} - y_{01}$ ,  $x_{m_2}$ ,  $y_{m_2} - y_{02}$ 和h ( $y_{01} + y_{02}$ ) 的值来。

定义参数 $\delta_m$ 为在电极临界范围内可允许的最大电场误差,则有:

$$\delta_m = (E(0) - E(u_m)) / E(0)$$
 (14)

由ð<sub>m</sub>的x轴分布情况我们就可以了解电极的放电性能,以便使我们能选取出—对满意的电极来。

实际的电极方程应是张氏理论方程乘上一个比例因子, 即:

$$x_i = \alpha u + \alpha k \cos v_i \sinh u \tag{15}$$

(i = 1, 2)

$$y_i = \alpha v_i + \alpha k \sin v_i \operatorname{ch} u \tag{16}$$

将 $x_{m1}$ 、 $y_{m1}-y_{01}$ 、 $x_{m2}$ ,  $y_{m2}-y_{02}$ 和h的值代入上面的方程可得:

$$x_{m,1} = \alpha u_{m,1} + \alpha k \cos v_1 \sin u_{m,1} \tag{17}$$

$$y_{m_1} - y_{01} = \alpha k \sin v_1 c h u_{m_1} - \alpha k \sin v_1$$
 (18)

$$x_{m_2} = \alpha u_{m_2} + \alpha k \cos v_2 \sinh u_{m_2} \tag{19}$$

$$y_{m_2} - y_{02} = \alpha k \sin v_2 \cosh u_{m_2} - \alpha k \sin v_2$$
 (20)

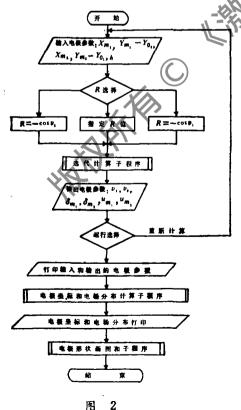
$$h = y_{0,1} + y_{0,2} = \alpha v_1 + \alpha k \sin v_1 + \alpha v_2 + \alpha k \sin v_2$$
 (21)

因为窄电极(即下电极)的表面基本上都处于有效放电区域内,需用张氏理论中的最大 平坦场条件即(7)式来约束k值,即:

$$k = -\cos v_2 \tag{22}$$

方程组(17)~(22)式共6个方程,6个未知 数( $\alpha$ ,  $k_1$ ,  $v_2$ ,  $v_2$ ,  $u_{m1}$ ,  $u_{m2}$ ),理 论上是可解的,实际的运算中,我们采用迭代法处理,具体步骤如下。

- (1) 给定v1、v2的初始值代入(22) 式求出k值。
- (2) 将k、v1、v2代入(21) 式求出α值。
- (3) 将a、k、v1、v2代入(18) 和(20) 式求出um1、um2的值。
- (4) 由 $\alpha$ 、k、 $u_{m1}$ 、 $u_{m2}$ 通过(17) 和(19) 式求出新的 $v_1$ 和 $v_2$ 值。



(5) 将新的 $v_1$ 、 $v_2$ 值作为初始值,重复上面的计算直至相邻的两次 $v_1$ 、 $v_2$ 值的差  $\Delta v_1$ 、 $\Delta v_2$ 达到我们所满意的精度要求。

上述迭代可使用微机处理。我们采用PC-1500袖珍电子计算机编制了一套设计程序[4], 其框图可参见图2。

利用此程序也可以设计镜象张氏电极,只要令输入语句中  $x_{m_1} = x_{m_2}$ ,  $y_{m_1} - y_{0_1} = y_{m_2} - y_{0_2}$ 即可。

本程序采用人机对话的方式,具有操作简单、功能齐全、运转迅速等优点。它不仅能准确地给出理论电极的形状和参数,还为我们进行经验模拟提供了极大的方便。

根据电场均匀度分布的情况并参照西德进口101型准分子激光器的放电电极设计,我们给出的电极尺寸为  $(x_{m1}, y_{m1}-y_{01}, x_{m2}, y_{m2}-y_{02}, h)=(15.5, 10, 27, 6, 24)。代入所编程序,由此可计算出理论电极的参数为: <math>k=2.86923\times10^{-1}, v_1=1.86182,$ 

 $v_2 = 7.01435 \times 10^{-1}, \quad \alpha = 7.93843_9$ 

#### 三、张氏电极的数控加工程序

对于给定解析方程的复杂曲面的精加工,比较有效的方法是使用带微机控制的数控机床。目前,我们采用的数控机床型号为UB-75,其操作语言系统为Fanuc-6MB,使用其宏指令编制用户宏程序[<sup>5</sup>],通过键盘输入系统,即可完成所要求的精加工。

张氏电极的剖面方程可简化为,

$$x = au + b \sin u \tag{23}$$

$$y = c + dc hu (24)$$

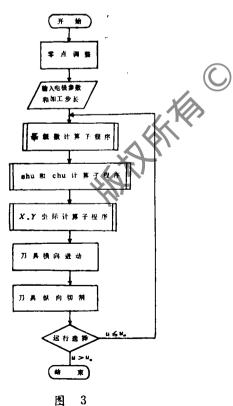
**由于加工中采用球形刀具,而我们控制**的只是刀具球心而非切点,因此需对上述方程进 **行加工方面的修正,其**结果如下:

$$X = au + b \operatorname{sh} u + \frac{R \cdot d \operatorname{sh} u}{\sqrt{(a + b \operatorname{ch} u)^2 + (d \operatorname{sh} u)^2}}$$
 (25)

$$Y = c + dc hu + \frac{-R \cdot (a + bc hu)}{\sqrt{(a + bc hu)^2 + (ds hu)^2}}$$
 (26)

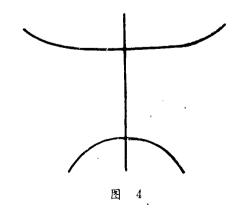
根据此方程编制的加工程序框图可参见图3。

**数**控编程的难点在于: (1)微机运算功能仅加、减、乘、除、乘方、开方等。对于双曲函数, 我们采用幂级数 展开法计算,其项数由精度要求确定。(2)微机运算时数值超过储存即自动 停车。对此,我们 在程序中采用了ROUND语句,及时去掉精度要求范围之外的尾数。我们 编制的数控程序计算精度为10<sup>-8</sup> mm,加工精度根据输入的步长确定,一般取10<sup>-3</sup> mm。



根据上述设计理论并参照张氏电极理论中的紧致性设计要求,我们使用微机和数控机床已设计并加工出一对电极(如图4)。在准分子激光器上试用,其放电的均匀性和紧致性都较好,放电宽度约为10mm。

本工作曾得到中国科技大学马兴孝教授和 北京机床所戴有虎高工的不少指教和帮助,在 此一并致谢。



#### 多考文献

- [1] 赫光生,雷任湛。激光器设计基础。上海:上海科学技术出版社,1979:186~188
- (2) Chang T Y. Rev Scient Instrum, 1973, 44 (4), 405~407
- [3] 曹洪如。张氏电极的设计计算程序。应用激光联刊。1983。3 (5)。61
- [4] 顾骏梁。PC-1500袖珍计算机 (BASIC) 语言实用程序设计。北京。煤炭工业 出版社。1985。306~316、391~392
- [5] 北京数控-发那科服务中心编。Fanuc System 6M-Model B 操作说明书 (上 册)。22~285

作者简介:徐春生, 男, 1966年3月出生。现担任牙膏分厂技术科长(代) 。主要从事牙膏生产技术管理、有关散射光学、胶体化学和流变学等方面的理论研究工作。

收稿日期: 1989年12月15日。收到修改稿日期: 1990年4月10日。

• 简 讯 •

# 二极管阵列探测器

新泽西州特伦顿Princeton仪器公司推出的INGAS-256NIR型二极管阵列探测器,全部使用标准性能指标(PI)的硬件和软件工作。该探测器由256个提供12.8mm 焦平面视野。在 $0.8\sim1.7\mu$ m光谱区内有响应度的InGaAs二极管阵列组成。该阵列探测器用热电致冷在 $0\sim-65$ ℃的温度范围之内,以保证最小的暗电荷。

译自 L F World, 1990 Jul: 172 邹福清 译 邹声荣 校

## 用于CO<sub>2</sub> 和YAG激光器的数字式功率探测器

由Oriel公司生产的手持式30型数字式功率探测器用于高功率激光器的功率级水平 检查 是理想的。这种装置由一台微处理机控制的数字功率计和一个功率计探头组成。探测头可用 于3W到11kW的功率级水平,一般最小限度的分辨率是探测头量程的0.1%。

> 译自 L & O, 1990, Aug. 68 张贤义、译 刘建卿 校